

01;05;12
 ©1993 г.

СРАВНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ДИСЛОКАЦИЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В КОМПЬЮТЕРНЫХ И ПРЯМЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ

С.П.Вагин, Д.Ш.Ибрагимова, Ю.С.Пятилетов, О.Г.Тюпкина, П.В.Чакров

Рассмотрено движение дислокационных ансамблей с учетом дальнодействующих взаимодействий и оценкой вклада этого взаимодействия в различные параметры, характеризующие движение дислокаций через точечные барьеры. Проведены сопоставления результатов ЭВМ эксперимента в приближениях одиночной дислокации и дислокационного ансамбля. Приводятся результаты электронно-микроскопического исследования образцов алюминия, облученных протонами с энергией 1 МэВ при температуре менее 100°С до дозы $7 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-2}$. Сравнение этих результатов с данными компьютерного эксперимента показало хорошее совпадение вероятностно-геометрических характеристик движения дислокаций. В частности, получено согласие между соответствующими распределениями по φ_i (характеризует силу взаимодействия дислокация-препятствие). Это дает возможность определять такие параметры, как мощности дефектов разного вида, их относительные концентрации и напряжения, действующие на дислокационные сегменты, используя имитационный компьютерный эксперимент.

Введение

К настоящему времени, используя (I) предположения барьерной модели и (II) рассматривая дислокацию в виде гибкой линии постоянного натяжения, различные авторы (начиная с Формена и Мейкина) решили самые разные задачи. В частности, с помощью ЭВМ экспериментов по моделированию движения дислокации через точечные барьеры проводились исследования, позволяющие имитировать деформацию в условиях нагружения с постоянной скоростью [1-3], ползучести [4-6], деформирования с постоянной скоростью [7] и т.д. Эксперименты такого рода позволяют решать как фундаментальные задачи, выявляя механизмы деформационных процессов, так и задачи прикладного характера по изучению закономерностей протекания деформации. Особенно успешно они использовались для исследований радиационного, твердорастворного и других типов упрочения металлов [8].

Однако сопоставление результатов ЭВМ расчетов, проводимых в предположениях I, II, с данными реальных экспериментов возможно лишь

при определенных условиях. А именно в тех случаях, когда деформация контролируется скольжением одиночных дислокаций и дальнодействующими взаимодействиями между дислокациями можно пренебречь.

По данным электронно-микроскопических исследований [9] в ряде металлов с определенной дефектной структурой такой механизм упрочнения имеет место при напряжениях, не превышающих критическое напряжение сдвига, и описывает малую часть реальных ситуаций.

В общем же случае дальнодействующие взаимодействия между дислокациями, в том числе и скользящими, играют заметную, а зачастую и решающую роль в процессе движения дислокаций и эволюции дефектных структур.

В работах [10,11] предложена модель компьютерного эксперимента, позволяющая исследовать самосогласованное движение взаимодействующих дислокаций в рамках предположений I, II. Основное отличие предложенной модели от классического варианта [1,3,4,8] заключается в том, что напряжение, действующее на сегменты, является результатом внешнего воздействия и дальнодействующих взаимодействий между скользящими дислокациями.

Как отмечалось выше, с помощью моделирования скольжения одиночных дислокаций получен довольно большой объем информации. В связи с этим определенный интерес могут вызвать оценки вклада, привносимого дальнодействующими взаимодействиями между скользящими дислокациями в различные параметры, характеризующие движение дислокаций в своих плоскостях скольжения. Это и явилось основной целью данной работы. Кроме того, проведено сравнение полученных результатов с данными электронно-микроскопических исследований.

Описание компьютерной модели формирования и движения дислокационных ансамблей

Предполагалось, что дефекты — это жестко закрепленные точечные барьеры, взаимодействующие со скользящими дислокациями в приближении сосредоточенной силы, а дислокации представляют собой гибкие линии постоянного натяжения. В рамках принятых приближений моделирование согласованного движения взаимодействующих дислокаций возможно, если известно как движется отдельная дислокация при наличии в этой же плоскости скольжения других и каким образом происходит передача движения между дислокациями.

Движение отдельной дислокации рассматривалось по классической схеме [1,8] посредством последовательного перехода ее из одной конфигурации в другую. Напряжения τ_N^k , действующие на сегменты N дислокации k , заставляют последнюю прогибаться между точечными барьерами и преодолевать их, если соответствующие углы прогибания φ^k меньше некоторого порогового значения φ_{cr}^N , характеризующего мощность препятствий. Дислокация движется до тех пор, пока не достигнет устойчивой конфигурации (все $\varphi^N > \varphi_{cr}^N$) или не выйдет на верхнюю границу площадки моделирования. Наличие других дислокаций влияет на движение рассматриваемой через τ_N^k .

Напряжения τ_N^k , действующие в центре сегментов N , вычислялись с учетом дальнодействующих взаимодействий между дислокациями по

формуле

$$\tau_N^k = \sum_n (\tau_{xy}^{(n)} \cos(\theta_2^{(n)})) + \tau_{ex} \cos \theta_1. \quad (1)$$

Суммирование проводится по всем сегментам дислокаций n , находящихся на площадке моделирования, за исключением рассматриваемого N ; θ_1 — угол между хордой сегмента N и осью, перпендикулярной τ_{ex} ; θ_2 — угол между хордами n и N ; τ_{ex} — внешнее напряжение.

Сдвиговые компоненты $\tau_{xy}^{(n)}$, обусловленные дальнодействующими взаимодействиями между сегментами n и N , рассчитывались в точке центра сегмента N согласно [11] (обозначим эту точку как (z_c, x_c)). Для этого дислокационные конфигурации аппроксимировались последовательностью прямолинейных отрезков примерно равной длины вдоль линии дислокации. Подчеркнем, что такая аппроксимация дислокационной линии использовалась только для вычислений τ_N^k . При анализе процесса прохождения дислокаций точечных барьеров дислокационные линии представляли собой последовательности сегментов, выгибающихся с радиусом $R_N^k = 1/(2\tau_N^k)$, если τ_N^k и R_N^k выражены в относительных единицах $\tau_0 = \mu b/l_0$ и среднего расстояния между препятствиями l_0 соответственно (μ — модуль сдвига, b — величина вектора Бюргерса).

Для краевых дислокаций с вектором Бюргерса b , направленным по τ_{ex} , сдвиговая компонента $\tau_{xy}^{(n)}$ будет иметь вид [12]

$$\tau_{xy}^{(n)} = \cos \theta \frac{1}{4\pi(1-\nu)x_c} \left(\frac{\lambda_x}{r_2} - \frac{\lambda_1}{r_1} \right). \quad (2)$$

Здесь θ — угол между отрезком n и осью, перпендикулярной τ_{ex} ; ν — коэффициент Пуассона; x_c — кратчайшее расстояние между точкой (z_c, x_c) сегмента N и отрезком n ; r_1 , r_2 и λ_1 , λ_2 — расстояния между концами отрезка n и точкой (z_c, x_c) и проекция этих расстояний на отрезок n соответственно.

В ЭВМ экспериментах на площадке моделирования размером $100l_0 \times 50l_0$ беспорядочным образом располагались 5000 точечных барьеров заданной мощности φ_{cr} . Считалось, что верхняя граница непроницаема для дислокаций, а на нижней работает источник. Он испускает краевые дислокации, если напряжение на старте больше нуля. На дислокации действует постоянное внешнее напряжение τ_{ex} , температура равна нулю.

Не вдаваясь в подробности, сформулируем основные принципы, позволяющие реализовать согласованное движение нескольких дислокаций в ЭВМ эксперименте.

Движение отдельной дислокации рассматривается при фиксированных положениях всех остальных. Так как локальные напряжения τ_N^k могут принимать как положительные, так и отрицательные значения, то перемещения соответствующих участков дислокации происходят как по, так и против τ_{ex} . После каждого элементарного акта перемещения для сегментов, участвующих в нем, пересчитываются τ_N^k .

После подвижки одной (любой) из дислокаций ансамбля анализируется возможность движения головной дислокации. Переход к анализу движения дислокации, лежащей ниже рассматриваемой, происходит, если

верхняя неподвижна. Эксперимент считается законченным, если соответствующие "стартовые" напряжения меньше (или равны) нуля. При проведении ЭВМ-экспериментов используются "зеркальные" граничные условия.

Сравнение параметров, характеризующих скольжение дислокаций в приближениях одиночных дислокаций и дислокационных ансамблей

В результате проведения подобных экспериментов на площадке моделирования образуются скопления краевых дислокаций. В области анализа преодоления барьеров отдельными дислокациями модель, позволяющая исследовать движение дислокационных ансамблей, имеет много общего с моделью Формена и Мейкина. Ясно, что это происходит из-за общности предположений, касающихся свойств дефектов и дислокаций.

Некоторое отличие заключается в частичном учете самодействия дислокаций. При расчетах напряжений, действующих на дислокационные сегменты, учитываются дальнодействующие поля напряжений от других сегментов своей дислокации. Рассмотрим движение одиночной дислокации с учетом этого фактора по соотношениям (1), (2). На рис. 1, а, б путь движения дислокации представлен в виде последовательности конфигураций, полученных в приближениях невзаимодействующих сегментов (а) и с учетом их дальнодействующих взаимодействий (б). Здесь же приведены гистограммы по напряжениям τ_N^1 .

Следует отметить, что при одинаковых по всей длине дислокации напряжениях (рис. 1, а) в процессе преодоления препятствий основную роль играют длины соседних сегментов и их наклон относительно друг друга. Те же факторы действуют и в случае б, но на "выпуклостях" дислокационной конфигурации напряжения обычно меньше, а на "вогнутых" участках больше τ_{ex} , что затрудняет развитие первых и подтягивает вторые. Очевидно, этот фактор и является причиной более равномерного движения дислокации, наблюдаемого в случае б.

Анализируя распределение по τ_N^1 , можно заметить, что абсолютное большинство сегментов (порядка 80%) испытывает напряжения, близкие к τ_{ex} . Все это приводит к выводу, что учет дальнодействующих взаимодействий в случае движения одиночной дислокации должен дать некоторые поправки к параметрам, характеризующим такой процесс. Тем не менее трудно ожидать, чтобы эти поправки были кардинальными. Следует отметить также, что с увеличением площади "заметания" для распределений по τ_N^1 присутствует эффект выхода на стационар.

Однако действие дислокационного сегмента самого на себя, позволяющее рассчитывать его форму, не учитывается. Согласно [13], это можно делать, хотя погрешность вычислений τ_{cr} составляет величину $\sim 10\%$ для таких "сильных" барьеров, как поры [14].

Проследим процесс формирования ансамблей скользящих дислокаций на препятствиях одной мощности при напряжениях, не превышающих критическое напряжение сдвига τ_{cr} . Напомним, что в данной работе под τ_{cr} понимается τ_{ex} , при котором головная дислокация скопления проходит всю площадку моделирования. Критическое напряжение сдвига одиночной дислокации обозначим τ_{cr}^0 .

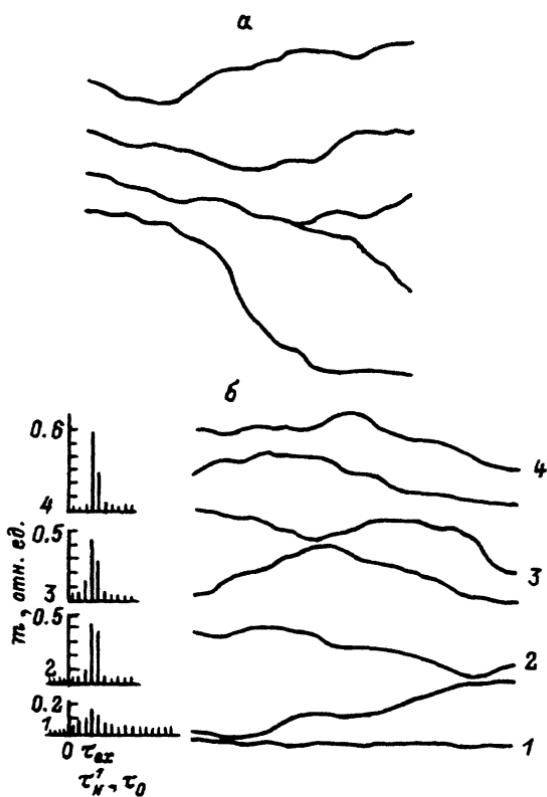


Рис. 1. Последовательности дислокационных конфигураций, наблюдающиеся при прохождении одиночной дислокацией препятствий одной мощности.

$\varphi_{cr} = 2.6$ рад, $\tau_{ex} = 0.2\tau_0$; *a* — в приближении невзаимодействующих сегментов; *b* — с учетом дальнодействующих взаимодействий между отдельными сегментами дислокации; *m* — доля сегментов (от их общего числа на конфигурации), попадающих в соответствующий интервал τ_N^1 . Нумерация гистограмм соответствует нумерации конфигураций.

Оказалось, что при выбранных напряжениях больших дислокационных ансамблей на площадке моделирования не образуется. Причем наблюдается некоторая закономерность между числом дислокаций в скоплениях и мощностью барьеров. Для "слабых" препятствий ($\varphi_{cr} \gtrsim 2.4$ рад) с ростом τ_{ex} наблюдалось появление второй дислокации на старте. Однако такая ситуация возникла при $\tau_{ex} > 0.5\tau_{cr}^0$. Это приводило к увеличению напряжения, действующего на головную дислокацию до величины $> \tau_{cr}^0$, и ее движению до границы площадки моделирования.

Для препятствий, подпадающих под разряд "средних" ($1.8 \lesssim \varphi_{cr} \lesssim 2.4$ рад) и "сильных" ($\varphi_{cr} < 1.8$ рад), аналогичная ситуация возникала при появлении третьей и четвертой дислокаций на старте соответственно. По-видимому, это является основной причиной незначительного изменения критического напряжения сдвига за счет формирования дислокационных скоплений. На рис. 2 приведены соответствующие зависимости.

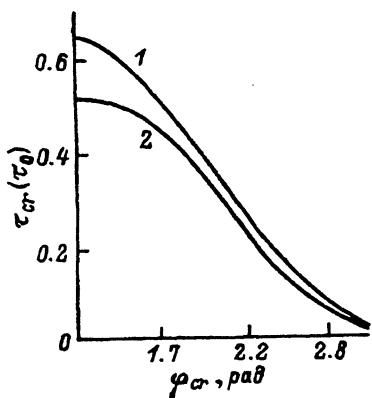


Рис. 2. Зависимость τ_{cr} от φ_{cr} .
 1 — для одиночной дислокации,
 2 — для дислокационных ансамблей.

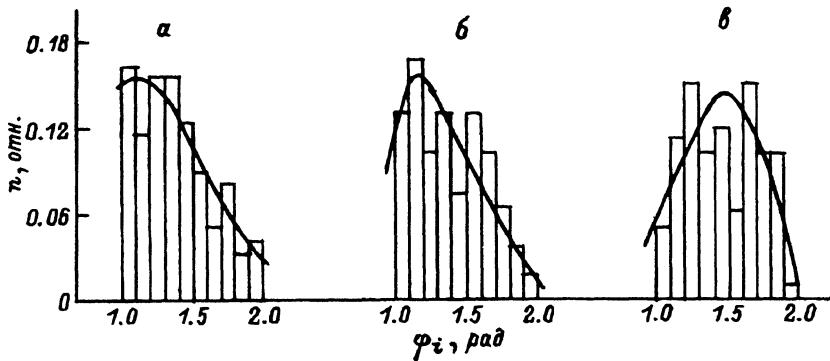


Рис. 3. Распределения по φ_i , полученные в приближении одиночной дислокации.
 $\varphi_{cr} = 1.6$ рад, $\tau_{cr} = 0.5\tau_0$; n — доля сегментов, подпадающих под соответствующий интервал φ_i ; а — $\tau_{ex} = 0.9\tau_{cr}$; б — $\tau_{ex} = 0.58\tau_{cr}$; в — $\tau_{ex} = 0.16\tau_{cr}$.

Теперь проанализируем такие вероятностно-геометрические характеристики движения дислокаций, как распределения по углам прогибания дислокации на соседних с i -м препятствиях φ_i (характеризует силу взаимодействия дислокация-препятствие i).

Для препятствий одной мощности в приближении одиночной дислокации наблюдается тенденция сдвига максимума распределения по φ_i в сторону больших углов (меньших сил) при уменьшении τ_{ex} . При этом распределение становится более симметричным и узким. На рис. 3 приведены соответствующие данные, иллюстрирующие сказанное. К настоящему времени в литературе накоплено довольно много информации по данному вопросу. В том числе известны попытки аналитического описания распределений подобного рода [15]. Заметим, что полученные результаты согласуются с литературными данными.

В том случае, когда моделируется скольжение дислокационных ансамблей, отмеченные тенденции изменения распределений по φ_i с уменьшением τ_{ex} сохраняются. При этом наблюдаются некоторые отличия в

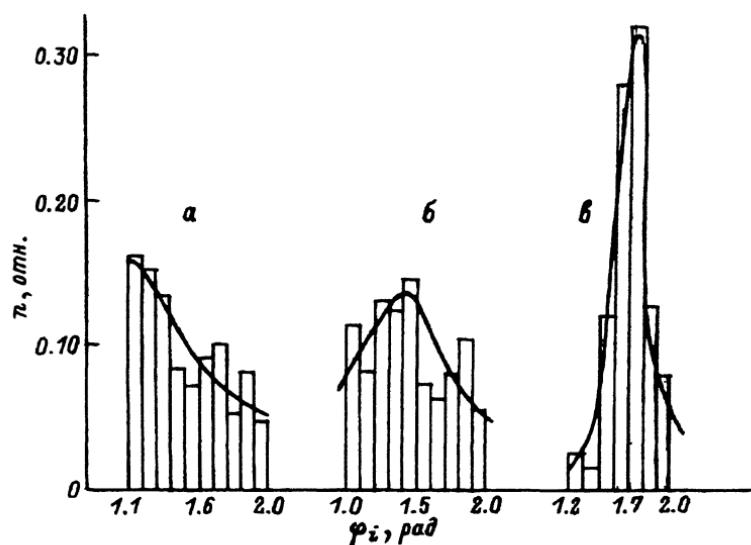


Рис. 4. Распределения по φ_i для 1-, 2-, 3-й дислокаций ансамбля (а, б и в соответственно).

$\varphi_{cr} = 1.6$ рад, $\tau_{ex} = 0.9\tau_{cr}$; нумерация начинается от головной дислокации ансамбля.

форме распределений. На рис. 4 приведены распределения по φ_i для дислокаций ансамбля, возникающего при тех же φ_{cr} и τ_{ex} , что и для случая, показанного на рис. 3, а. Видно, что распределения имеют более пологую форму. С удалением от головы скопления максимум распределения смещается в сторону меньших сил (больших углов).

Проанализируем ситуацию для двух типов препятствий. На рис. 5, а-в приведены распределения по φ_i , полученные при моделировании скольжения одиночных дислокаций (в) и дислокационных ансамблей. Видно, что данные распределения описываются двумя гармониками. Из вида распределений можно предложить следующие заключения. Распределения, полученные в приближениях одиночных дислокаций и дислокационных ансамблей, качественно подобны. Разделение распределений на две составляющие (по числу типов препятствий) прослеживается для всех дислокаций ансамбля и более всего заметно для головной дислокации ансамбля. Наиболее отчетливо данный эффект проявляется при напряжении, близком к τ_{cr} . С уменьшением τ_{ex} гармоники распределения приобретают более пологую форму, увеличивается их перекрывание. Начиная с некоторого напряжения τ^* гармоники становятся неразличимыми. При параметрах, заданных для рис. 5, $\tau^* \cong 0.4\tau_{cr}$.

Таким образом, при $\tau \leq \tau_{cr}$ на площадках моделирования с хаотическим пространственным расположением препятствий больших дислокационных скоплений не возникает. Дислокационные ансамбли, включающие десятки и более дислокаций, могут возникать на границах (если выполняются условия их непроницаемости) при $\tau > \tau_{cr}$ [10,11]. Следует подчеркнуть, что данный вывод получен в предположениях барьерной модели для дефектов, пространственное расположение которых характеризуется как равномерное. Специфичные пространственные расположе-

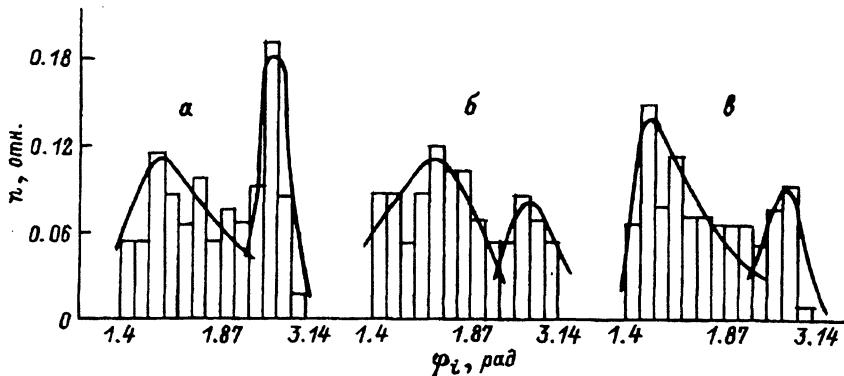


Рис. 5. Распределения по φ_i , полученные в приближениях одиночной дислокации (θ), дислокационных ансамблей (α, β) для 1-й и 3-й дислокации соответственно.

$\varphi_{cr}^1 = 2.8$ рад, $\varphi_{cr}^2 = 1.4$ рад, $\kappa_{\varphi_1} = 0.6$ (относительная концентрация препятствий, имеющих φ_{cr}^1); $\tau_{ex} = 0.9\tau_{cr}$.

жения в виде скоплений "сильных" дефектов могут привести к другим результатам.

В рамках предположений, принятых в данной работе, учет возможности формирования ансамблей дислокаций одного знака и дальнодействующих взаимодействий между ними не вносит существенных изменений в качественное поведение основных параметров, описывающих скольжение дислокаций. Влияние указанных эффектов проявляется в том, что движение дислокаций становится более равномерным (рис. 1). Уменьшается напряжение прохождения дислокациями площадки моделирования рис. 2. Поправка к величине τ_{cr} увеличивается с ростом φ_{cr} и достигает 20% для "сильных" препятствий. Функции распределений по φ_i имеют более плавный вид. На них хорошо выявляется влияние препятствий различной мощности (рис. 3-5).

Все это, во-первых, лишний раз доказывает правомерность тех многочисленных работ, в которых на основании результатов по моделированию скольжения одиночных дислокаций предпринимались попытки найти объяснение экспериментальным закономерностям. Во-вторых, можно надеяться, что поправки, привносимые дальнодействующими взаимодействиями между дислокационными сегментами, приведут к лучшему согласию результатов компьютерных и реальных экспериментов.

Сравнение результатов компьютерных экспериментов с данными электронно-микроскопических исследований

Основываясь на закономерностях поведения распределений по φ_i , изложенных выше, попытаемся проанализировать электронно-микроскопические изображения дефектной структуры. В качестве основной задачи поставим следующую: на основании распределений по φ_i , полученным из электронно-микроскопических изображений дефектной структуры и компьютерных экспериментов по моделированию движения дислокаций, оценить мощности φ_{cr} и относительные концентрации дефектов



Рис. 6. Фрагмент электронно-микроскопического изображения дефектной структуры облученного алюминия.

разного типа, а также среднее напряжение, действующее на дислокационные сегменты.

В качестве объекта исследований были выбраны образцы алюминия, облученного протонами с энергией 1 МэВ при температуре менее 100 С до дозы $7 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-2}$. При указанных условиях в конце пробега протонов наблюдались газовые поры размером 15–300 нм и плотностью $0.2\text{--}1.5 \times 10^{18} \text{ см}^{-3}$, а также единичные дислокации и их скопления (рис. 6). Для получения количественной информации выбирались области с порами близкого размера (15–25 нм), на которых были закреплены прогнувшиеся дислокации, расположенные под малым углом к поверхности образца, что проверялось стереоскопическим анализом. Кроме того, прогибание протяженных дислокаций имело место при их взаимодействии с "торчковыми" дислокациями, ориентированными перпендикулярно поверхности и невидимыми в данных дифракционных условиях (рис. 7). В основном их присутствие отмечалось не столько визуально, сколько за-

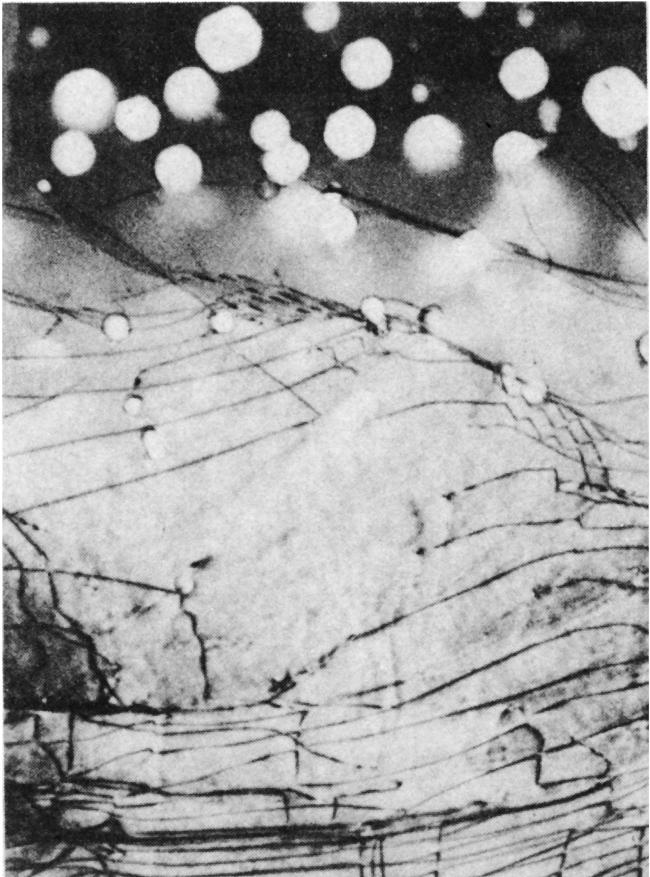


Рис. 7. Фрагмент дислокационной структуры облученного алюминия.

счет характерного изгиба протяженных дислокаций. В связи с этим набрать необходимую статистику для достоверной оценки концентрации барьеров этого типа в данном случае не представляется возможным.

Таким образом, можно полагать, что в данном случае дефектная структура состоит преимущественным образом из препятствий двух типов и дислокаций, расположенных поодиночке или в виде небольших дислокационных скоплений. Кроме того, на основании этих электронно-микроскопических данных можно считать, что предположения барьевой модели (I, II) могут быть приняты.

Информация, получаемая из электронно-микроскопических снимков, дает возможность установить плотность и средний размер пор и построить распределение по углам прогибания дислокационных сегментов φ_i . Из этих распределений мы попытаемся определить мощность дефектов разного типа φ_{cr}^1 и φ_{cr}^2 . Далее, используя их в качестве исходных параметров компьютерного эксперимента, найдем χ , имеющие критический угол срыва φ_{cr}^1 (χ — относительная концентрация пор) и среднее напряжение, действующее на дислокационные сегменты. Основным критерием правильности проведенных оценок будем считать совпадение соответствующих распределений по φ_i .

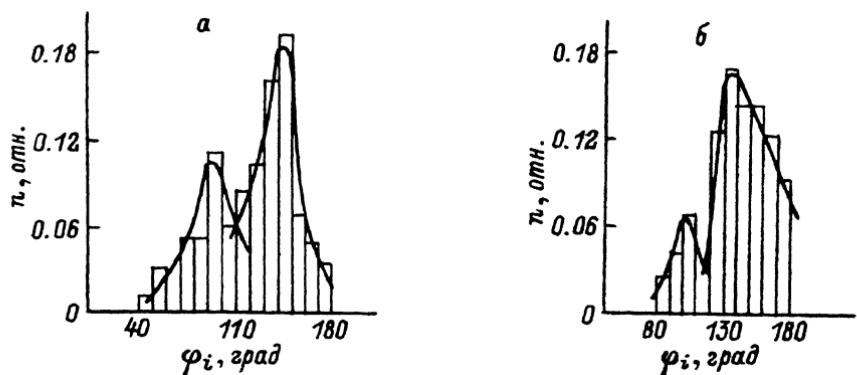


Рис. 8. Распределения по φ_i , полученные (а) из анализа электронно-микроскопических изображений дефектной структуры облученного алюминия и (б) компьютерного эксперимента.

Распределение по φ_i , полученное из электронно-микроскопических изображений, приведено на рис. 8,а. Вид распределения является характерным для препятствий двух типов и позволяет достаточно однозначно оценить φ_{cr}^1 и φ_{cr}^2 . Ясно, что их значения определяются величиной углов (φ_i), расположенных во фронте соответствующих пиков. В качестве φ_{cr}^1 и φ_{cr}^2 приняты значения 2.2 и 1.4 рад для газовых пор и „торчковых“ дислокаций соответственно. С использованием этих данных проведены компьютерные эксперименты (по методике, описанной в предыдущих разделах) при различных значениях κ и τ_{ex} . Шаг по κ составлял 0.1 от общей концентрации, напряжение варьировалось с шагом 0.01 от τ_{cr} .

Оказалось, что лучшее согласие между распределениями, полученными из компьютерных экспериментов и электронно-микроскопических наблюдений, имеет место при $\kappa = 0.7$ и $\tau = 0.6\tau_{cr}$ (рис. 8,б). Основные отличия полученного распределения от экспериментально наблюдаемого заключаются в том, что первый пик имеет почти в два раза меньшую высоту, а фронт спадания второго пика менее симметричен, чем в исходном распределении. Однако мы остановились на выбранных параметрах, так как при больших κ высота первого пика становится еще меньше, а при меньших (с учетом выбранного шага по κ) пики становятся соизмеримыми по высоте. С ростом напряжения выше $0.6\tau_{cr}$ возрастает величина первого пика, но форма пиков искажается еще больше, стремясь к виду, показанному на рис. 4,а. При $\tau < 0.6\tau_{cr}$ пики начинают сливатся.

Таким образом, согласие между информацией, полученной из электронно-микроскопических наблюдений, и результатами компьютерных экспериментов дает основание считать торможение скользящих дислокаций локальными дефектами одним из основных механизмов деформации при $\tau_{ex} < \tau_{cr}$. Наряду с этим следует отметить, что полного количественного совпадения получить не удалось, что свидетельствует, на наш взгляд, о необходимости учета других возможных механизмов деформации. Кроме того, данный вывод справедлив, если наблюдаемая дефектная структура позволяет говорить о приемлемости основных предположений, используемых в соответствующих расчетах.